

Samsung realizza memoria DDR3 da 4Gb e 50nm

- Ultima modifica: Giovedì, 29 Gennaio 2009 19:46

Pubblicato: Giovedì, 29 Gennaio 2009 17:59

Scritto da Federico Diana



Il chipmaker coreano Samsung ha annunciato lo sviluppo del primo chip di memoria DDR3 da 4Gbit, realizzato con un processo produttivo a 50 nanometri: con la nuova tecnologia si potranno implementare moduli di memoria RAM più capienti e performanti.

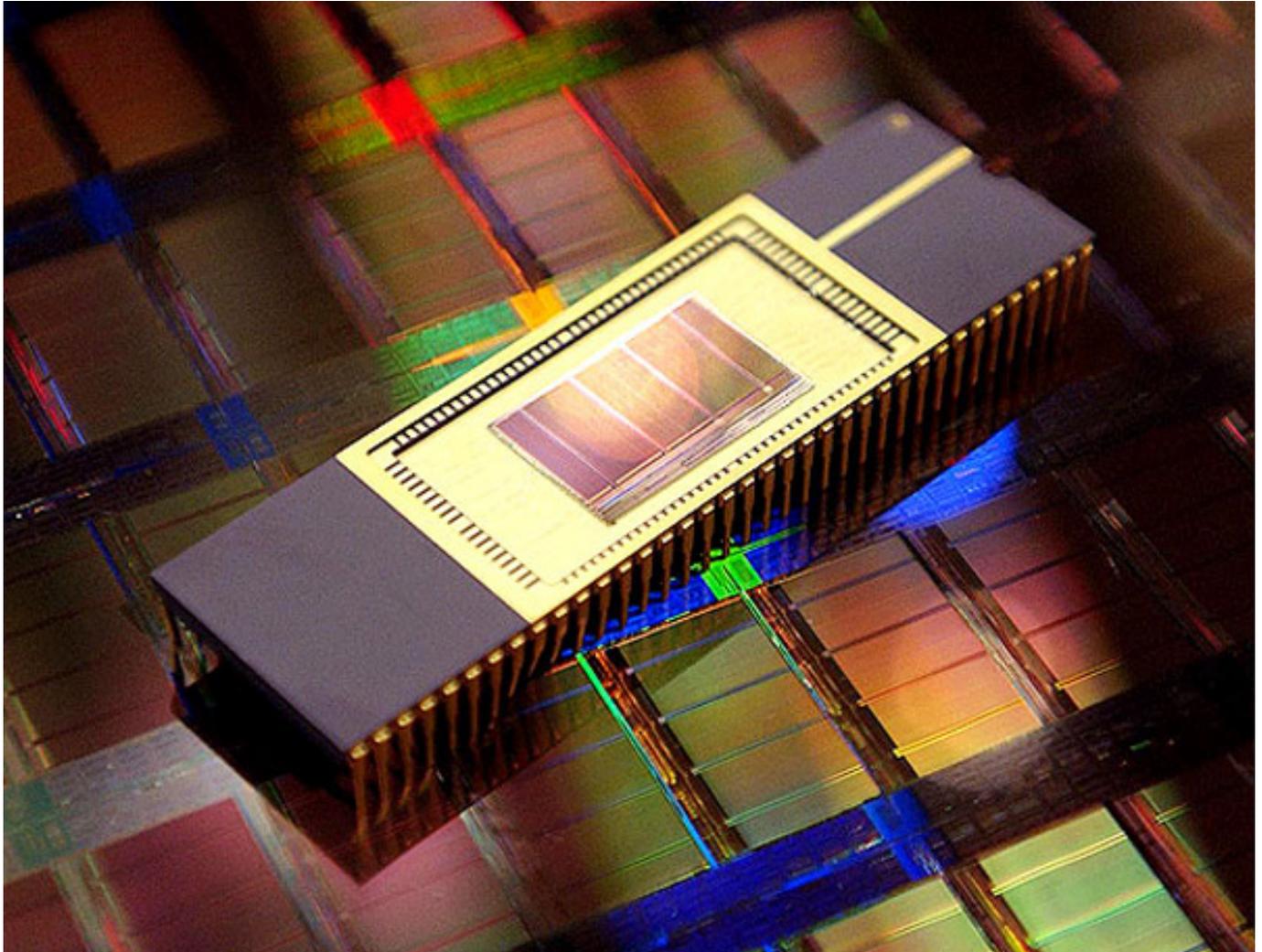
Samsung [annuncia oggi](#) il raggiungimento di un importante traguardo relativo alla tecnologia di produzione delle **memorie RAM DDR3**, sviluppando il primo chip con **densità di 4Gb (gigabit)** al mondo: per lo sviluppo è stato utilizzato un processo produttivo a **50 nanometri**, che non solo permette di creare chip dalle **piccole dimensioni ed elevata densità**, ma contribuisce anche alla riduzione dei consumi e del calore generato. Grazie ad i nuovi chip realizzati dal produttore coreano, sarà possibile venire incontro alle esigenze dei data center, che potranno ridurre i costi ed incrementare l'efficienza tramite l'utilizzo di un minor numero di server con più memoria RAM installata.

Samsung realizza memoria DDR3 da 4Gb e 50nm

- Ultima modifica: Giovedì, 29 Gennaio 2009 19:46

Pubblicato: Giovedì, 29 Gennaio 2009 17:59

Scritto da Federico Diana



I chip da **4Gb DDR3 di Samsung** saranno impiegati per la produzione di moduli di memoria RDIMM per server (registered dual in-line memory modules) da **16GB**, moduli UDIMM (unbuffered DIMM) da **8GB** per workstation e normali PC, e persino moduli SODIMM (small outline DIMM) per sistemi **notebook**. Sfruttando invece la tecnologia dual-die package, sarà possibile integrare su un singolo modulo fino a 32GB di memoria DDR3. I nuovi chip sono stati inoltre progettati per ridurre ulteriormente i consumi rispetto alle normali memorie DDR3 da 1.5V: sono infatti in grado di operare a 1.35V, e di raggiungere una velocità di trasferimento dati **pari ad 1.6Gbps**.

Il risparmio di energia sarà dunque notevolissimo per soluzioni ad elevata densità: se prendiamo in considerazione una configurazione da 16GB, sfruttando i chip da 4Gb DDR3 si avrà un consumo inferiore di addirittura il 40% rispetto alla medesima configurazione realizzata con chip da 2Gb.

Samsung realizza memoria DDR3 da 4Gb e 50nm

- Ultima modifica: Giovedì, 29 Gennaio 2009 19:46

Pubblicato: Giovedì, 29 Gennaio 2009 17:59

Scritto da Federico Diana

"Con lo sviluppo dei nostri chip di memoria DDR3 da 4Gb, realizzati con il processo produttivo di ultima generazione a 50nm, abbiamo posto le basi per una rivoluzione che si tradurrà in un significativo risparmio sui costi per il mercato server e per quello globale" ha dichiarato Kevin Lee, VP del settore Technical Marketing, Samsung Semiconductor, Inc.